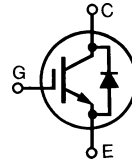


Low $V_{CE(sat)}$ IGBT with Diode
High Speed IGBT with Diode

IXGH/IXGT 15N120BD1
IXGH/IXGT 15N120CD1

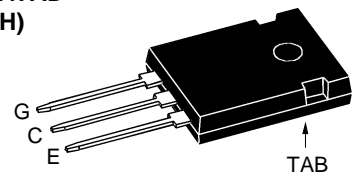
V_{DSS}	I_{C25}	$V_{CE(sat)}$
1200 V	30 A	3.2 V
1200 V	30 A	3.8 V

Preliminary data

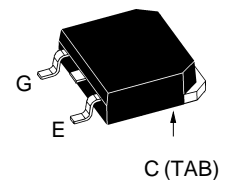


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	1200	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GE} = 1\text{ M}\Omega$	1200	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	30	A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ\text{C}$	15	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, 1 ms	60	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15\text{ V}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$, $R_G = 10\ \Omega$ Clamped inductive load	$I_{CM} = 40$ @ $0.8 V_{CES}$	A
P_C	$T_C = 25^\circ\text{C}$	150	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque	1.13/10	Nm/lb.in.
Maximum lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300	$^\circ\text{C}$
Maximum tab temperature soldering SMD devices for 10s		260	$^\circ\text{C}$
Weight		TO-247AD/TO-268	6/4 g

TO-247AD
(IXGH)



TO-268
(IXGT)



G = Gate C = Collector
 E = Emitter TAB = Collector

Features

- International standard packages: JEDEC TO-247AD & TO-268
- IGBT and anti-parallel FRED in one package
- MOS Gate turn-on
 - drive simplicity
- Fast Recovery Exipitaxial Diode (FRED)
 - soft recovery with low I_{RM}

Applications

- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switch-mode and resonant-mode power supplies

Advantages

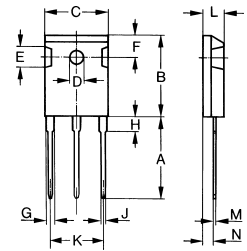
- Saves space (two devices in one package)
- Easy to mount with 1 screw (isolated mounting screw hole)
- Reduces assembly time and cost

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
BV_{CES}	$I_C = 1\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	1200		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\ \mu\text{A}$, $V_{CE} = V_{GE}$	2.5		5.0 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$ $V_{GE} = 0\text{ V}$		2	500 μA mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 20\text{ V}$			$\pm 100\text{ nA}$
$V_{CE(sat)}$	$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$ Note 2	15N120BD1 15N120CD1		3.2 V 3.8 V

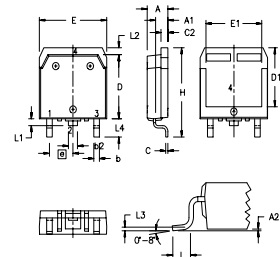
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g_{fs}	$I_C = I_{C90}; V_{CE} = 10\text{ V}$, Note 2.	12	15	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		1700	pF
C_{oes}		155	pF	
C_{res}		38	pF	
Q_g	$I_C = I_{C90}, V_{GE} = 15\text{ V}, V_{CE} = 0.5 V_{CES}$		69	nC
Q_{ge}		13	nC	
Q_{gc}		26	nC	
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C90}; V_{GE} = 15\text{ V}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}; R_G = R_{off} = 10\ \Omega$ Note 1.		25	ns
t_{ri}		15	ns	
$t_{d(off)}$		150	280	ns
t_{fi}		15N120BD1 160 15N120CD1 115	320 190	ns ns
E_{off}		15N120BD1 1.75 15N120CD1 1.05	3.0 1.6	mJ mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C90}; V_{GE} = 15\text{ V}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}; R_G = R_{off} = 10\ \Omega$ Note 1.		25	ns
t_{ri}		18	ns	
E_{on}		1.5	mJ	
$t_{d(off)}$		270	ns	
t_{fi}		15N120BD1 360 15N120CD1 250	ns mJ	
E_{off}	15N120BD1 3.5 15N120CD1 2.1	mJ mJ		
R_{thJC}	TO-247			0.83 K/W
R_{thCK}		0.25	K/W	

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_F	$I_F = 20\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 20\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_J = 125^\circ\text{C}$	2.6	2.8	V
I_F	$T_C = 25^\circ\text{C}$ $T_C = 90^\circ\text{C}$		33	V
I_{RM}	$I_F = 20\text{ A}; -di_F/dt = 400\text{ A}/\mu\text{s}, V_R = 600\text{ V}$	15	A	
t_{rr}	$V_{GE} = 0\text{ V}; T_J = 125^\circ\text{C}$	200	ns	
t_{rr}	$I_F = 1\text{ A}; -di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}; V_R = 30\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$	40	ns	
R_{thJC}			1.6	K/W

- Notes:
- Switching times may increase for V_{CE} (Clamp) $> 0.8 \cdot V_{CES}$, higher T_J or increased R_G .
 - Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$

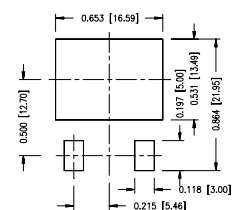
TO-247 AD (IXGH) Outline


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	19.81	20.32	0.780	0.800
B	20.80	21.46	0.819	0.845
C	15.75	16.26	0.610	0.640
D	3.55	3.65	0.140	0.144
E	4.32	5.49	0.170	0.216
F	5.4	6.2	0.212	0.244
G	1.65	2.13	0.065	0.084
H	-	4.5	-	0.177
J	1.0	1.4	0.040	0.055
K	10.8	11.0	0.426	0.433
L	4.7	5.3	0.185	0.209
M	0.4	0.8	0.016	0.031
N	1.5	2.49	0.087	0.102

TO-268AA (D³ PAK)


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.9	5.1	.193	.201
A ₁	2.7	2.9	.106	.114
A ₂	.02	.25	.001	.010
b	1.15	1.45	.045	.057
b ₂	1.9	2.1	.75	.83
C	.4	.65	.016	.026
D	13.80	14.00	.543	.551
E	15.85	16.05	.624	.632
E ₁	13.3	13.6	.524	.535
e	5.45 BSC		.215 BSC	
H	18.70	19.10	.736	.752
L	2.40	2.70	.094	.106
L ₁	1.20	1.40	.047	.055
L ₂	1.00	1.15	.039	.045
L ₃	0.25 BSC		.010 BSC	
L ₄	3.80	4.10	.150	.161

Min.
Recommended
Footprint



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9